

Cesta De Limpieza De Obleas De Ptfе De Alta Pureza, Portador De Obleas De Silicio Resistente A Ácidos, Bastidor De Grabado De Fluoropolímero

Número de artículo: PL-CP284



Introducción

Garantiza un procesamiento semiconductor sin contaminación con nuestras cestas de limpieza de obleas de PTFE de alta pureza. Diseñadas para procesos de grabado y limpieza agresivos, estos portadores personalizables ofrecen una resistencia química y estabilidad térmica excepcionales para el manejo de obleas de silicio durante los procesos críticos de fabricación química húmeda.

[Aprende más](#)

| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|---------------------------------------|---|--|
| Limpieza estándar RCA | Pasos secuenciales de limpieza SC-1 y SC-2 para eliminar residuos orgánicos y contaminantes metálicos de las obleas de silicio. | Evita la lixiviación de iones metálicos, garantizando entornos de procesamiento ultra puros. |
| Grabado Piranha | Uso de mezclas de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno para eliminar materiales orgánicos pesados y fotorresistencia. | Soporta reacciones exotérmicas extremas y oxidación agresiva sin degradarse. |
| Inmersión/Grabado con HF | Eliminación de capas de óxido sacrificiales u óxidos nativos mediante soluciones de ácido fluorhídrico. | Inmunidad completa al ataque de HF, que destruiría los portadores de vidrio o cuarzo. |
| Texturizado de células solares | Inmersión de obleas de silicio en soluciones alcalinas o ácidas para crear texturas superficiales de captación de luz. | Rendimiento de alto volumen y resistencia a soluciones concentradas de KOH o NaOH. |
| Limpieza post-CMP | Eliminación de partículas de lechada y residuos químicos después del pulido químico-mecánico. | La superficie antiadherente evita la redeposición de lechada en el portador y las obleas. |
| Fotolitografía | Pasos de revelado y eliminación que involucran disolventes orgánicos agresivos y reveladores. | La construcción resistente a disolventes garantiza que no se produzca hinchamiento ni ablandamiento del material del portador. |
| Limpieza por ultrasonidos | Limpieza acústica de alta frecuencia de componentes electrónicos delicados en soluciones acuosas. | Transmite la energía ultrasónica de forma efectiva al proteger los componentes de impactos mecánicos. |
| Procesamiento de GaAs | Grabado químico húmedo y limpieza de sustratos semiconductores compuestos para optoelectrónica. | Soporte suave y seguro para sustratos frágiles durante pasos críticos de fabricación. |

| Parámetro | Descripción / Especificación (Serie PL-CP284) |
|--|--|
| Número de artículo del producto | PL-CP284 |
| Material principal | PTFE virgen de alta pureza (Politetrafluoroetileno) |
| Compatibilidad química | Universal (Ácidos fuertes, bases, disolventes, oxidantes) |
| Tamaños estándar de oblea | Compatible con obleas de 4 pulgadas, 6 pulgadas y 8 pulgadas |
| Opciones de personalización | Dimensiones, cantidad de ranuras y anchos de ranura totalmente personalizables |

| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Parámetro | Descripción / Especificación (Serie PL-CP284) | |
| Configuraciones de mango | Estilos fijos, desmontables o compatibles con robots (Personalizable) | |
| Temperatura de funcionamiento | -200°C a +260°C (continuo) | |
| Acabado de superficie | Superficie de baja porosidad, mecanizada por CNC de alta precisión | |
| Diseño de ranura | Perfiles en V o personalizados para un área de contacto mínima | |
| Proceso de fabricación | 100% mecanizado por CNC para precisión e integridad estructural | |
| Nivel de pureza | Grado de análisis de trazas, fabricación sin metales | |